

## СОХАЦКИЙ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ

### Личные данные:

Дата и место рождения: 18 ноября 1964 г., Астрахань

Женат, дочь – 32 лет, сын – 23 лет.

Постоянное место жительства: г. Дубна, пр-т Боголюбова, д.16, кв. 96.

Рабочий телефон: 216-32-12, 216-28-31.

Домашний телефон: 212-62-21

Мобильный телефон: 8-906-720-02-12

Эл. почта: [sohatsky@jinr.ru](mailto:sohatsky@jinr.ru)

### Образование:

1982 – 1988 г.г.: Московский физико-технический институт.

Факультет молекулярной и химической физики

### Ученая степень:

2002 г. - Кандидат физико-математических наук (тема диссертации: “Радиационное повреждение кремния низкоэнергетическими ионами гелия”)

Научно- профессиональная деятельность: 1988 г. – по настоящее время:

Последовательно: инженер, мл. науч. сотр.; научный сотрудник, начальник сектора 2 Центра Прикладной физики Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова Объединённого института ядерных исследований, начальник группы Радиационной физики Сектора №8 Ионно-имплантационных нанотехнологий и радиационного материаловедения ЛЯР.

Сфера деятельности: радиационная физика твердого тела, материаловедение, радиационное воздействие излучений на металлы и полупроводники, просвечивающая электронная микроскопия.

### Награждения и поощрения:

2000 г. – Первая премия. ОИЯИ за работу "Новые ионно-имплантационные методы для нанотехнологии".

2005 г. – Поощрительная премия ОИЯИ за работу "Влияние гелия на ионно-имплантационное синтезирование наноразмерных фазовых структур в твердых телах".

2008 г. – Первая премия ОИЯИ за работу "Темплетная технология формирования металлических наноструктур" в области научно-технических прикладных работ.

### Публикации:

Автор и соавтор 55 научных работ. 2 авторских свидетельства на изобретения.